

Qualcomm Snapdragon 835 : 20 % plus rapide que le 820

[VideoCardz](#) vient de mettre la main sur des slides de présentation de **Qualcomm** relatifs à son nouveau processeur mobile de haut de gamme, **le Snapdragon 835**.

Gravé en 10 nm FinFET, ce composant sera bien plus compact que le Snapdragon 820. Mais aussi plus performant. **+20 %** grâce à son CPU Kryo 280, combinant 4 cœurs à 2,45 GHz et 4 cœurs à 1,9 GHz. Qualcomm précise que le processeur devrait rester **80 % du temps** sur les 4 cœurs à basse consommation.

Le GPU Adreno 540 proposera le support des dernières technologies en date, allant de DirectX 12 en passant par l'API Vulkan et le décodage de vidéos en 4K. Le rendu graphique devrait être **25 %** plus rapide que précédemment. Du lourd donc.

Ajoutez à ceci un DSP Hexagon plus puissant, un Spectra (dédié aux prises de vue) plus fonctionnel et un module de sécurité Haven enrichi. Le S835 promet d'être la star de l'année 2017. Côté 4G, le modem X16 LTE sera **de classe gigabit**.

Un composant hot hot hot

Concentrer autant de puissance sur une puce aussi petite ne manquera pas de poser des problèmes de chauffe. La présentation de Qualcomm indique que le Snapdragon 835 consomme **moitié moins d'énergie que le 801**. Mais aussi moins que le 820.

Le problème ne réside pas toutefois dans la consommation moyenne, **mais dans les pics de charge**. Et ici, le Snapdragon 835 pourrait atteindre des sommets. Les paramètres thermiques de la batterie du smartphone seront toutefois pris en compte par le processeur, en particulier lors de sa phase de recharge rapide, laquelle peut mener à une chauffe importante.

À lire aussi :

[Le Qualcomm Snapdragon 835 plus rapide que l'A10 Fusion d'Apple ? 10 nm et charge rapide : Qualcomm renouvelle ses gammes Qualcomm rassure les marchés. Grâce au Snapdragon 820 ?](#)